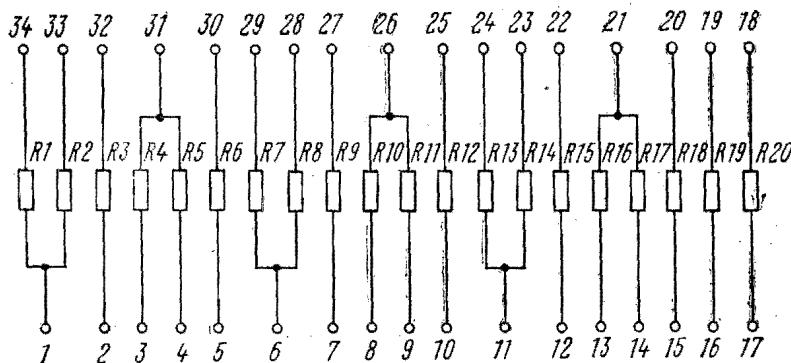


**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ
НАПРЯЖЕНИЯ**

**313HP310
313HP311**

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



| Позиционное обозначение | Расчетный номинал |
|-------------------------|-------------------|
| <i>R1—R20</i> | <i>R</i> |

Значение сопротивления резистора *R*

| Тип микросхемы | Номинальное значение сопротивления, кОм | Предельное отклонение, % |
|----------------|---|--------------------------|
| 313HP310 | 30 | 5 |
| 313HP311 | 30 | 10 |

**313НР310
313НР311**

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ
НАПРЯЖЕНИЯ**

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25°C)

| | |
|--|---------------------|
| Допускаемое отклонение коэффициента деления, %, не более | ±0,0075 |
| Напряжение на входе, В, не более | 30 |
| Время установления выходного напряжения, мкс, не более | 1 |
| Сопротивление изоляции (напряжение измерения 100 В прикладывается между экраном и закороченны- ми выводами), МОм, не менее | 1000 |
| Сопротивление резисторов R , кОм: для микросхемы 313НР310 | от 28,731 до 31,247 |
| » » 313НР311 | от 27,222 до 32,737 |

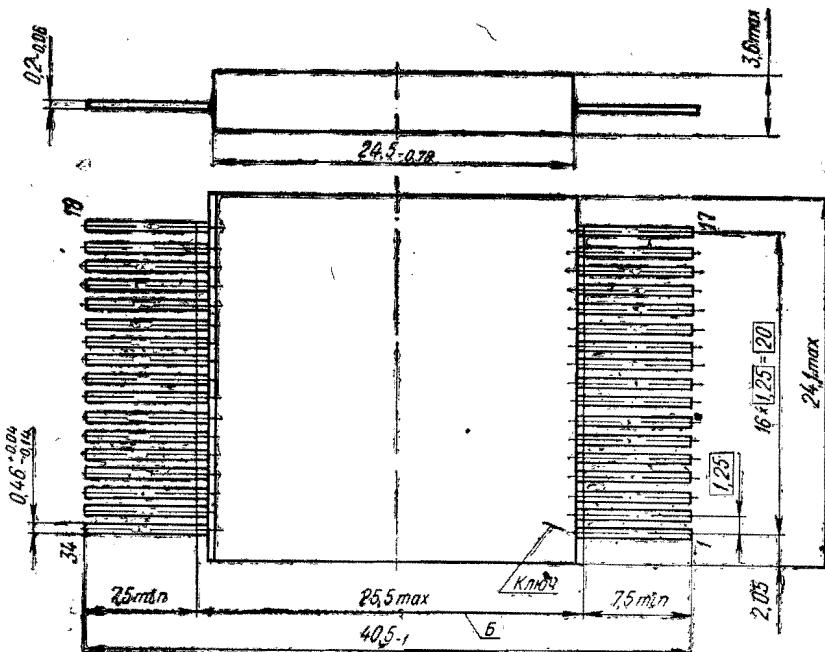
**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

| | |
|--|----|
| Максимальное входное напряжение, В | 30 |
|--|----|

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 313

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОСТАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ (КОРПУС 4137.34-1)



Масса не более 4,5 г

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

| | |
|--|--------------|
| диапазон частот, Гц | от 1 до 5000 |
| амплитуда ускорения, м·с ⁻² (g) | 400 (40) |

Механический удар одиночного действия:

| | |
|--|---------------|
| пиковое ударное ускорение, м·с ⁻² (g) | 15 000 (1500) |
| длительность действия ударного ускорения, мс | от 0,1 до 2,0 |

Механический удар многократного действия:

| | |
|--|------------|
| пиковое ударное ускорение, м·с ⁻² (g) | 1500 (150) |
| длительность действия ударного ускорения, мс | от 1 до 5 |

Линейное ускорение, м·с⁻² (g)

5000 (500)

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 813

Общие данные

Акустический шум:

| | |
|--|-----------------------------------|
| диапазон частот, Гц | от 50 до 10 000 |
| уровень звукового давления, дБ | 170 |
| Атмосферное пониженное давление, мм рт. ст. (Па) | 10^{-6} ($1,3 \cdot 10^{-4}$) |
| Атмосферное повышенное давление, атм | 3 |
| Повышенная температура среды, °С | 100 |
| Пониженная температура среды, °С | минус 60 |
| Изменения температуры среды, °С | от минус 60 до +100 |
| Иней, роса. | |
| Соляной туман. | |
| Среда, зараженная плесневыми грибами. | |

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка[○], ч:

| | |
|---|--------|
| для микросхем 813НР1(А—М) | 25 000 |
| для остальных микросхем | 15 000 |
| Срок сохраняемости [○] , лет | 25 |

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Допустимое значение статического потенциала 100 В.

Допускается эксплуатация микросхем при 100%-ной перегрузке по напряжению с сохранением точностных характеристик в течение времени не более 96 ч.

Допускается эксплуатация микросхем в течение 1 ч при температуре 125°C с увеличением погрешности выходного напряжения до 10%. Температура жала паяльника при распайке микросхем на плату — не более 265°C. Время касания к каждому выводу:

для одножального паяльника — не более 3 с;

для группового паяльника — не более 2 с.

Интервал между пайками соседних выводов — не менее 3 с. Интервал между двумя повторными пайками одной микросхемы — не менее 5 мин.

Микросхемы устанавливаются на платы вплотную. Допускается обрезка незадействованных выводов.

Микросхемы после установки их на платы покрываются лаком ЭП-730 ГОСТ 20824—81. Количество слоев — 3.

[○] В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.